MEASUREMENT OF BEAM SIZE USING SR INTERFEROMETER AT NEWSUABRU STORAGE RING

Shintarou Hisao¹, Takahiro Matsubara, Satoshi Hashimoto, Yoshihiko Shoji, Ainosuke Ando NewSUBARU, Laboratory of Advanced Science and Technology for Industry (LASTI), University of Hyogo 1-1-2 Kouto, Kamigori, Ako, Hyogo 678-1205, Japan

Abstract

A vertical beam size is usually so small in a light source that the visible light profile monitor can't measure accurately. So we constructed the SR interferometer and measured the vertical beam size. By varying the vertical beam size with RF shaker, contributions of Touschek effect and gas scattering effect to lifetime were measured and the life was found to be mainly determined by Tousheck effect in 1.0GeV and by gas scattering in 1.5GeV.

NewSUBARUにおける放射光干渉計を用いたビーム診断

1. はじめに

ニュースバル電子蓄積リング^[1]は、ビーム診断と して可視光プロファイルモニター^[2]を設置している。 偏向電磁石から放出されたシンクロトロン放射光を 金メッキ銅ブロックミラーで大気中に取り出し、ミ ラーとレンズを用いて結像させバンドパスフィル ターを通して可視光をCCDカメラで観測している。 しかし、ニュースバルの垂直方向のビームサイズは、 このモニターの分解能以下になっているため正確な 測定ができない。そこで、放射光干渉計モニター^[3] の設置及び垂直方向のビームサイズの測定を行った。

2. 測定原理

シンクロトロン放射光をダブルスリットで干渉さ せ、その干渉の度合い(Visibility)からビームサイズ を求める事ができる。Van Citterut-Zernikeの定理より 光源の大きさは、複素コヒーレント度のフーリエ変 換で与えられる^[4]。

$$Visibility = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} |\gamma|$$
(1)

$$\gamma = \int \rho(x) \exp(-\frac{2\pi i D}{\lambda L} x) dx \tag{2}$$

ここで、*I*₁と*I*₂は各スリットからの光強度、γは複素 コヒーレンス度、ρ(x)はx方向における光源の分布 関数、*L*は光源からダブルスリットまでの距離、Dは ダブルスリットのスリット間隔、λは波長である。 ダブルスリットのスリットの方向を水平方向、ある いは垂直方向に変える事により両方向の光源の大き さを測定できる。また、光源がガウス分布と仮定す ると、以下の関係式が求まる。

$$\sigma = \frac{\lambda L}{\pi D} \sqrt{\frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{\gamma}\right)}$$
(3)

ここで、σはRMS電子ビームサイズである。これよ り一つの測定データからビームサイズを測定できる。

3. 実験セットアップ

図.1に実験セットアップの概略図を示す。ダブル スリットを通過した光は、レンズ(f=1000mm)によっ て結像され干渉縞を作る。偏光フィルターでσモー ドの光を選択し、500nmバンドパスフィルター (FWHM=10nm)で波長を決め、CCDカメラで干渉縞 を観測する。観測した干渉縞は同軸ケーブルを用い て画像入力ポートでモノクロ画像としてパーソナル コンピュータに取り込む。LabVIEW及びIMAQソフ トウェアを用いて画像処理を行い、干渉縞の強度分 布をピクセル深度8ビットのデジタルデータで取得 する。干渉縞の強度分布のデータを式(4)でフィッ ティングしVisibilityを求める。干渉縞の強度分布の 式を以下に示す。

$$I(x) = I_0 \{ sinc(\frac{2\pi a}{\lambda F}x) \}^2 \{ 1 + |V| \cos(\frac{2\pi D}{\lambda F}x) + \theta \}$$
(4)

ここで、 I_0 は光の強度、aはスリットの半分の高さ、 FはダブルスリットからCCDカメラまでの距離、V はVisibility、 θ は干渉縞の初期位相である。



¹E-mail:shinta@lasti.u-hyoao.ac.jp

4. 実験結果

4.1 ビームサイズの測定結果



ダブルスリットのスリット間隔Dを変化させ Visibilityを測定した。その結果を以下に示す。

図.2 スリット間隔D(mm)とVisibilityの関係。横軸は スリット間隔、縦軸はVisibilityである。実線は水平 方向、破線は垂直方向である。

図.2の結果からRMSビームサイズを求めると水平方向は209µm、垂直方向は93µmとなった。エミッタンス値は水平方向が53nm、垂直方向が0.4nmとなりカップリング定数は0.75%となった。設計値の水平方向のエミッタンスは、40nmであり予想より大きい値になった。可視光プロファイルモニターの結果は38nmであり^{[2][5]}、バンプ電磁石を用いて真空チェンバーで電子ビームを削る事によってビームサイズを求める方法からでは36nmであった^{[2][5]}。垂直方向のエミッタンスは、カップリング定数から求めた結果^[5]と一致した。放射光干渉計から求める方法では、Visibilityの測定誤差がビームサイズの誤差に反映させる。Visibilityの測定誤差は、冷却水配管及び床面の振動により干渉縞が揺れてしまう事から生じ、Visibility値で約±0.05であった。

4.2 可視光プロファイルモニターとの比較

2台のSkewマグネットでカップリング補正を行い、 垂直方向のビームサイズを小さくして可視光プロファイルモニターと放射光干渉計モニターでサイズ を測定し性能を比較した。Touschek寿命は、ビーム サイズに比例する事からカップリング補正により ビームサイズが小さくなっている事は寿命の測定か ら判断できる。測定結果を図.3に示す。可視光プロ ファイルモニターはビームサイズの変化を測定でき なかったが、放射光干渉計モニターは寿命とほぼ比 例した測定結果が得られた。放射光干渉計モニター は、可視光プロファイルモニターの測定範囲外でも 測定可能である事がわかった。



図.3 垂直方向のビームサイズの測定結果。横軸は 寿命(hours)、縦軸は垂直方向のビームサイズ(µm)で ある。実線は放射光干渉計モニター、破線は可視光 プロファイルモニターである。

放射光干渉計モニターの測定限界はスリット間隔の 大きさ及びVisibilityの測定精度で決まる。スリット 間隔を大きくすればより小さいビームサイズが測定 できる。ニュースバルの放射光干渉計モニターの垂 直方向の最大スリット間隔は、実験ホールまで導く ミラーの大きさで決まる。その間隔は、30mmであ りVisibility値が0.8とすると約20µmまで測定可能と なる。Visibility値が1付近ではビームサイズの変化 に対するVisibilityの変化が乏しい事と1付近では CCDカメラのノイズなどから測定精度が悪く正確な 値が測定できない^[6]。

4.3 ビームサイズと寿命の変化

ニュースバルは、RFシェーカーで電子ビームを垂 直方向にkickし垂直方向のベータトロン振動を励起 させビームサイズを大きくする事により寿命を延ば し利用運転を行っている。電流値を一定でRFシェー カーのパワーを変化させ積極的に垂直方向のビーム サイズを変え、パワーに対するビームサイズ及び寿 命を測定し、Touschek寿命とガス散乱寿命を求めた。 RFシェーカーのonとoffの干渉縞の違いを以下に示 す。



図.4 干渉縞の違い。左図はRFシェーカーがoffであり、右図はonである。

図.4から左図の方が干渉の度合い(Visibility)が高く、 左図が右図より垂直方向のビームサイズが小さい事 を意味している。 RFシェーカーのパワーに対する垂直方向のビームサ イズ及び寿命の測定結果を示す。



図.5 垂直方向のビームサイズと寿命の変化。横軸は RFシェーカーのパワー (W)、縦軸は左が垂直方向の ビームサイズ(µm)、右が寿命(hours)である。実線が ビームサイズ、破線が寿命である。

電子ビーム寿命は以下の式で表される。

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{Touschek}} + \frac{1}{\tau_{Gas}} + \frac{1}{\tau_{Ion}} + \frac{1}{\tau_{Quantum}}$$
(5)

寿命(τ)は、Touschek寿命、ガス散乱寿命、イオント ラッピングによって決まる寿命、量子寿命で決まる。 量子寿命は、他と比べて非常に長時間なのでここで は無視し、イオントラッピング効果による寿命の減 少はイオンクリアリング装置とフィリングパターン により寿命の減少がないと仮定する。Touschek寿命 はビームサイズに比例している事から式(5)は、以 下のようになる。

$$\frac{1}{\tau} \approx \frac{1}{\tau_{Touschek}} + \frac{1}{\tau_{Gas}} = \frac{A}{\sigma_y} + \frac{1}{\tau_{Gas}}$$
(6)

ここで、Aは定数、σ_yは垂直方向のビームサイズで ある。ビームサイズの逆数と寿命の逆数をプロット して線形フィットすることにより、切片からガス散 乱寿命、傾きからTouschek寿命が求まる。1.0GeV、 200mAにおける測定結果を示す。



図.6 観測した寿命と垂直方向のビームサイズの逆数 の関係。横軸は垂直方向のビームサイズの逆数(mm⁻¹)、縦軸は寿命の逆数(hours⁻¹)である。

1.0GeVと1.5GeVの場合の寿命の内訳を表.1にまとめた。

表.1 1.0GeVと1.5GeVのTouschek寿命とガス散乱寿命

1.0GeV 200mA	RF shaker OFF	RF shaker 35W	
全ビーム寿命	1.8	4.8	
ガス散乱寿命	14.3		
Touschek寿命	2.1	7.2	

1.5GeV 110mA	RF shaker OFF	RF shaker 35W
全ビーム寿命	13.3	14.5
ガス散乱寿命	19.2	
Touschek寿命	43.4	58.8
		(単位はhours)

電子エネルギーが1.0GeVではTouschek寿命が、 1.5GeVではガス散乱寿命が支配的である事がわかった。

5.まとめ

放射光干渉計モニターの設置及びビームサイズの 測定を行った。結果、可視光プロファイルモニター では困難であった垂直方向のビームサイズの測定に 成功した。また、RFシェーカーを用いて垂直方向の ビームサイズと寿命の測定から1.0GeVではTouschek 寿命が、1.5GeVではガス散乱寿命が支配的である事 がわかった。

謝辞

放射光干渉計モニターの光学系を検討するにあった助言をいただいたSpring-8 加速器グループの正 木満博氏に心よりお礼申し上げます。

参考文献

[1] A. Ando, et al., J. Synchrotron Rad. 5, 342 (1998).

[2] A.Ando, *et al.*, "Beam size blow up and energy widening in NewSUBARU", Nucl. Instrum. Methods. Phys. Res. A481, p.43-47 (2002).

[3] M.Katoh and T.Mitsuhashi, "Measurement of beam size at the photon factory with the SR interferometer", PAC'99.

[4] 谷田貝豊彦, "光とフーリエ変換",株式会社朝倉 書店.

[5] 福田義博, 博士論文,"ニュースバルのビームサイ ズ測定に関する研究", (2002).

[6] T.Naito and T.Mitsuhashi, "Development of SR interferometer with reflecting focus mirror and the small beam size measurement at ATF-DR", Proc.加速器学会, p.578, (2004).